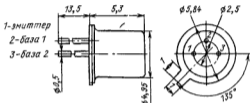


2Т117А, 2Т117Б, 2Т117В, 2Т117Г, КТ117А, КТ117Б, КТ117В, КТ117Г

Транзисторы кремниевые планарные однопереходные с *n*-ба-
зой

Предназначены для работы в маломощных генераторах
Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выво-
дами Обозначение типа приводится на корпусе
Масса транзистора не более 0,45 г



Электрические параметры

Коэффициент передачи напряжения при $U_{Б1Б2} = 10$ В	
при $T = 298$ К	
2Т117А, 2Т117В, КТ117А, КТ117В	0,5 – 0,7
2Т117Б, 2Т117Г	0,65 – 0,85
КТ117Б, КТ117Г	0,65 – 0,90
при $T = 343$ К	
2Т117А, 2Т117В, КТ117А, КТ117В	0,45 – 0,7
2Т117Б	0,6 – 0,85
2Т117Г	0,6 – 0,8
КТ117Б, КТ117Г	0,6 – 0,9
при $T = 213$ К	
2Т117А, 2Т117В, КТ117А, КТ117В	0,5 – 0,8
2Т117Б, 2Т117Г	0,65 – 0,9
КТ117Б, КТ117Г	0,65 – 0,95
Ток включения эмиттера при $U_{Б1Б2} = 10$ В не бо- лее	
20 мкА	
Ток выключения эмиттера при $U_{Б1Б2} = 20$ В не ме- нее	
1 мА	
Остаточное напряжение эмиттер-база не более	
при $T = 213 - 298$ К	5 В
при $T = 343$ К, $I_3 = 10$ мА 2Т117А, 2Т117Б, 2Т117В, 2Т117Г	4 В
при $T = 343$ К, $I_3 = 50$ мА КТ117А, КТ117Б, КТ117В, КТ117Г	4 В

Межбазовое сопротивление:

при $T = 298 \text{ K}$:

2Т117А, 2Т117Б	4–7,5 кОм
2Т117В, 2Т117Г	6–9 кОм
КТ117А, КТ117Б	4–9 кОм
КТ117В, КТ117Г	8–12 кОм

при $T = 343 \text{ K}$:

2Т117В, 2Т117Г	6–15 кОм
КТ117В, КТ117Г	6–18 кОм

при $T = 213 \text{ K}$:

2Т117В, 2Т117Г	3–8,5 кОм
КТ117В, КТ117Г	4–12 кОм

Температурный коэффициент межбазового сопротивления 0,1–0,9%/К

Наибольшая частота генерации 200 кГц

Обратный ток эмиттера при $U_{Б1Б2} = 30 \text{ В}$ не более:

при $T = 298 \text{ K}$	1 мкА
при $T = 398 \text{ K}$	10 мкА

Ток модуляции не менее 10 мА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное межбазовое напряжение 30 В

Постоянное напряжение база-эмиттер 30 В

Постоянный ток эмиттера 50 мА

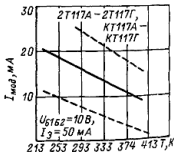
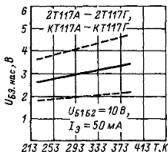
Импульсный ток эмиттера при $\tau_n < 10 \text{ мкс}$, $Q \geq 200$ 1 А

Постоянная рассеиваемая мощность эмиттера:

при $T = 213 \div 308 \text{ K}$	300 мВт
при $T = 398 \text{ K}$	15 мВт

Температура перехода 403 К

Температура окружающей среды От 213 до 398 К



Зона возможных положений зависимости напряжения насыщения база-эмиттер от температуры.

Зона возможных положений зависимости тока модуляции от температуры.